


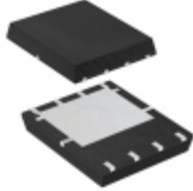






	DMT10H025SSSS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT10H025SSSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFETN-CHAN 100V SO-8
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMT10H025SSSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMT10H025SSSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFETN-CHAN 100V SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	DMT10H025SSSS-13DITR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1544pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7.4A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Ta)

DMT10H025SSSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT10H025SSSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT10H025SSSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ DMT10H025SSSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT10H015LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 61V 100V TO252 T&R</p>	 <p>DMT10H015LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 7.3A</p>	 <p>DMT10H015LSS DIODES DMT10H015LSS DIODES</p>	 <p>DMT1D1K Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 1000PF 10% 100VDC RAD</p>
 <p>DMT1D22K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 2200PF 10% 100VDC RAD</p>	 <p>DMT1D1K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 1000PF 10% 100VDC RAD</p>	 <p>DMT1D22K Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 2200PF 10% 100VDC RAD</p>	 <p>DMT1D15K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 1500PF 10% 100VDC RAD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

[Mehr](#)

DMT10H025SSSS-13 Diodes Incorporated	DMT10H025SSSS-13 Datenblatt	DMT10H025SSSS-13-Datenblätter	DMT10H025SSSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT10H025SSSS-13
DMT10H025SSSS-13 Electronic	DMT10H025SSSS-13-Komponenten	DMT10H025SSSS-13-Verteiler	DMT10H025SSSS-13-Bild	DMT10H025SSSS-13-Teil
DMT10H025SSSS-13 Preis	DMT10H025SSSS-13 Hersteller	DMT10H025SSSS-13 Bild	DMT10H025SSSS-13 Aktie	DMT10H025SSSS-13 Inventar
DMT10H025SSSS-13 Neu	DMT10H025SSSS-13 Original	DMT10H025SSSS-13 garantiert	DMT10H025SSSS-13 RFQ	DMT10H025SSSS-13 Online bestellen